

頁	行	誤	正
25	下から5行目	3.2.2 3次元の逆格子	3.2.2 3次元の逆格子点
57	式(4.36)の次の行	と表される。	と表される。ここで、 \mathbf{r} は動径ベクトル、 \mathbf{p} は運動量である。
84	式(6.6)の次の行	が得られる。	が得られる。ただし、 $S_{21} = \int \phi_2^* \phi_1 d\mathbf{r}$ である。
	式(6.7)の次の行	c_1, c_2 が0でないためには、	c_1, c_2 がともに0でないためには、
147	下から7行目	$\phi(\mathbf{r})$ はブロッホの定理より $\phi(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$	$\phi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ はブロッホの定理より $\phi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$
148	式(10.22)	$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\mathbf{G}_m} C_{\mathbf{G}_m} e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G}_m)\cdot\mathbf{r}}$	$\phi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\mathbf{G}_m} C_{\mathbf{G}_m} e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G}_m)\cdot\mathbf{r}}$
251	下から6行目	半導体の有効質量および誘電率を	半導体の有効質量および比誘電率を
266	下から9行目	磁化率は $\chi = -1$ となる。	磁化率は $\chi_m = -1$ となる。